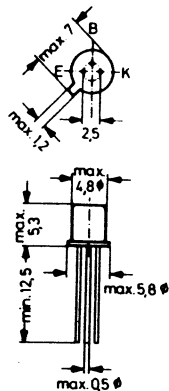


## PNP-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor für Verstärker- und Schalteranwendungen

Metallgehäuse JEDEC TO-18  
18 A 3 nach DIN 41 876  
Gewicht ca. 0,35 g  
Kollektor mit Gehäuse verbunden  
Maße in mm



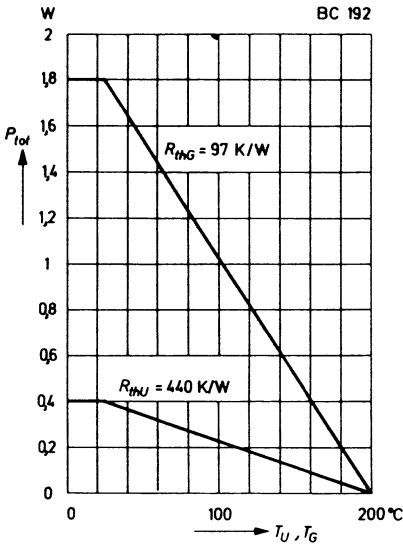
### Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	25	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CE0}$	25	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EB0}$	5	V
Kollektorstrom	$-I_C$	500	mA
Basisstrom	$-I_B$	100	mA
Verlustleistung bei $T_U = 25^\circ\text{C}$ bei $T_G = 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	0,4	W
	$P_{tot}$	1,8	W
Sperrschichttemperatur	$T_i$	200	$^\circ\text{C}$

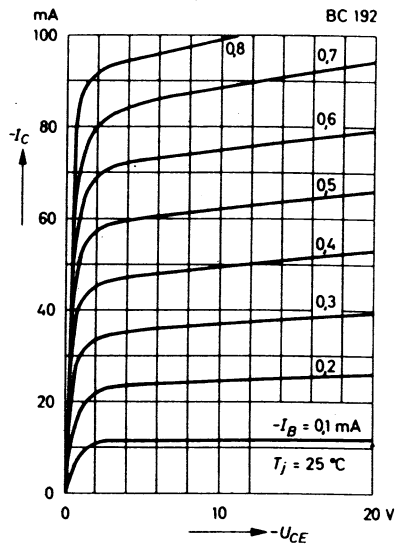
### Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Kollektor-Basis-Stromverhältnis bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$ , $-I_C = 50\text{ mA}$	$B$	60 ... 180	
Kollektor-Sättigungsspannung bei $-I_C = 50\text{ mA}$ , $-I_B = 5\text{ mA}$	$-U_{CEsat}$	< 0,25	V
Kollektorreststrom bei $-U_{CB} = 20\text{ V}$	$-I_{CB0}$	10 (< 100)	nA
Kollektor-Basis-Kapazität bei $-U_{CB} = 10\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_{CB0}$	12	pF
Transitfrequenz bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$ , $-I_C = 50\text{ mA}$	$f_T$	> 100	MHz
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft Sperrschicht – Gehäuse	$R_{thU}$	< 440	K/W
	$R_{thG}$	< 97	K/W

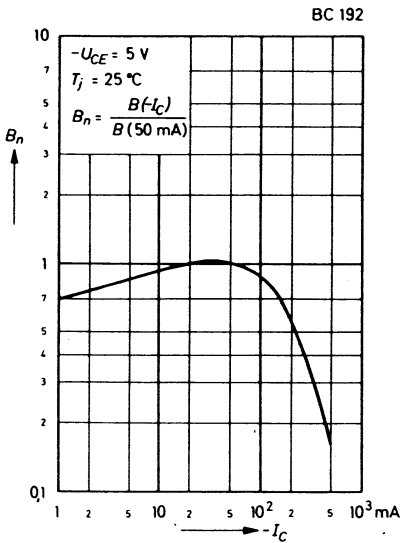
## zulässige Gesamtverlustleistung in Abhängigkeit von der Temperatur



## Ausgangskennlinien Emitterschaltung



## Kollektor-Basis-Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



## Kollektorreststrom in Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur

